



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22406XE

Issue Date:15 May 2020

Title of Change:	Qualification of ON Niigata, Japan as additional wafer source for ON Semiconductor BAV99LT1G and BAV99LT3G with legacy, non-monolithic die design.	
Proposed First Ship date:	22 Aug 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Hiroshi.Koizumi@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Dustin.Tenney@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be identified with date code. Date code 2032 onwards may be sourced from additional wafer fab once FPCN expires.	
Change Category:	Wafer Fab Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Niigata, Japan	None	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia		
Description and Purpose:		
ON Semiconductor is notifying customers of the qualification of ON Niigata, Japan as additional wafer source for ON Semiconductor BAV99LT1G and BAV99LT3G with legacy, non-monolithic die design. The affected products listed in this notification are currently sourced from ON Semiconductor ISMF fabrication facility in Seremban, Malaysia. Niigata Fab facility is an ON Semiconductor owned wafer fab that has been producing products for ON Semiconductor. Several existing technologies within ON Semiconductor's product families are currently sourced from Niigata Fab. ON Semiconductor Niigata Wafer Fab is an internal factory that is TS16949, ISO-9001 and ISO-14000 certified. Qualification tests are designed to show that the reliability of the transferred devices will continue to meet or exceed ON Semiconductor standards		
	Before Change Description	After Change Description
Wafer fab	ON Semiconductor ISMF FAB, Malaysia	ON Semiconductor ISMF FAB, Malaysia ON Semiconductor Niigata, Japan
There is no product marking change as a result of this change.		



Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME NSVBAS21SLT1G

RMS: L46827

PACKAGE: SOT23

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	2016 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	30000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-	0/30

QV DEVICE NAME BAS21LT1G

RMS: L46828

PACKAGE: SOT23

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/77

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
BAV99LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV99LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22406XE

発行日: 15 May 2020

変更件名:	オン・セミコンダクターのレガシー非モノシリックダイ設計であるオン・セミコンダクター BAV99LT1G および BAV99LT3G の追加ウェハー供給拠点としてオン・セミコンダクター新潟株式会社 (日本) の認定	
初回出荷予定日:	22 Aug 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Hiroshi.Koizumi@onsemi.com にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.Samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または Dustin.Tenney@onsemi.com にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは PCN.Support@onsemi.com 宛てをお願いします。	
変更部品の識別:	影響を受ける製品は日付コードで識別されます。 日付コード 2032 は、FPCN の有効期限切れ以降、追加のウェハー工場から供給されることになります。	
変更カテゴリ: ウェハファブの変更		
変更サブカテゴリ: 製造拠点の追加		
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Niigata, Japan	無し	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia		
説明および目的:		
レガシー非モノシリックダイ設計であるオン・セミコンダクター BAV99LT1G および BAV99LT3G の追加ウェハー供給拠点としてオン・セミコンダクター新潟株式会社 (日本) の認定をお客様にお知らせいたします。		
この通知にリストされた対象製品は、現在、セレンバン (マレーシア) にあるオン・セミコンダクター ISMF 工場から供給されています。		
新潟ウェハー工場は、オン・セミコンダクター製品の製造を行っている自社のウェハー工場です。現在、オン・セミコンダクター製品ファミリーのいくつかの既存技術は新潟工場から提供されています。オン・セミコンダクター新潟ウェハー工場は、自社工場であり、TS16949、ISO-9001、および ISO-14000 の認証を受けています。認定試験は、移管された製品の信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となることを証明するように設計されています。		
	変更前の表記	変更後の表記
ウェハー工場	ON Semiconductor ISMF FAB, Malaysia	ON Semiconductor ISMF FAB, Malaysia ON Semiconductor Niigata, Japan
この変更に伴い製品マーキングに変更はありません。		



信頼性データの要約:

デバイス名 : NSVBAS21SLT1G

RMS: L46827

パッケージ : SOT23

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	2016 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	30000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-	0/30

デバイス名 : BAS21LT1G

RMS: L46828

パッケージ : SOT23

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/77

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。特性評価データはご要求に応じてご提供可能です。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
BAV99LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV99LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G